



2SA1201 (3CG1201)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于一般功率放大。

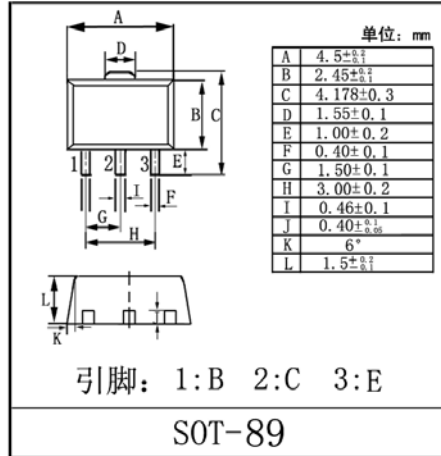
Purpose: power amplifier applications.

特点: 特征频率高, 电压高, 封装小, 与 2SC2881 (3DG2881) 互补。

Features: High f_T , high V_{CE0} , small flat package, complementary pair with 2SC2881 (3DG2881).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-120	V
V_{CE0}	-120	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-800	mA
I_B	-160	mA
P_C	500	mW
P_C^*	1.0	W
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



*:Mounted on ceramic substrate (250mm²×0.8t)

*装于 250mm²×0.8t 的陶瓷上。

电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CE0}	$I_C=-10\text{mA}$	$I_B=0$	-120			V
V_{EB0}	$I_C=-1.0\text{mA}$	$I_C=0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-120\text{V}$	$I_E=0$			-0.1	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=-5.0\text{V}$	$I_C=0$			-0.1	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-100\text{mA}$	80		240	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$	$I_B=-50\text{mA}$			-1.0	V
V_{BE}	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-500\text{mA}$			-1.0	V
f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V}$	$I_C=-100\text{mA}$		120		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$	$I_E=0$			30	pF

h_{FE} 分档、印章标记/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	0	Y
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	80~160	120~240
印章 Marking	HDO \ddagger	HDY \ddagger

